S1NBB80

800V 1A

特 長

- 小型 DIP パッケージ
- 端子間 3.4mm

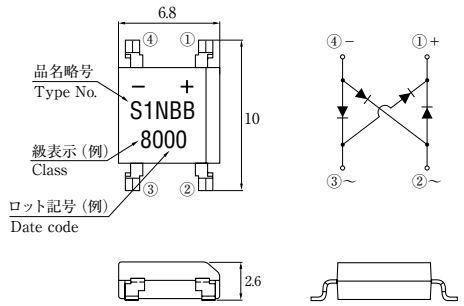
Feature

- Small-DIP
- Pin-distance 3.4mm for isolation

■外観図 OUTLINE

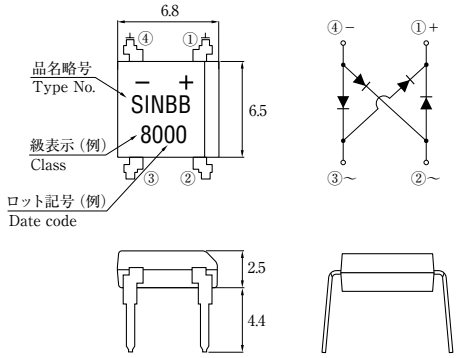
Package：1NA

Unit : mm
Weight : 0.29g(typ.)



Package：1NA

Unit : mm
Weight : 0.29g(typ.)



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings（指定のない場合 $Tl=25℃$／unless otherwise specified）

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1NBB80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			−40～150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波，抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	Ta＝26℃ *1	1	A
			Ta＝25℃ *2	0.84	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波，非繰り返し 1 サイクルせん頭値，Tj＝25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj＝25℃		50	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	1ms≦t＜10ms，Tj=25℃，1 素子当たりの規格値 per diode		6	A^2s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics（指定のない場合 $Tl=25℃$／unless otherwise specified）

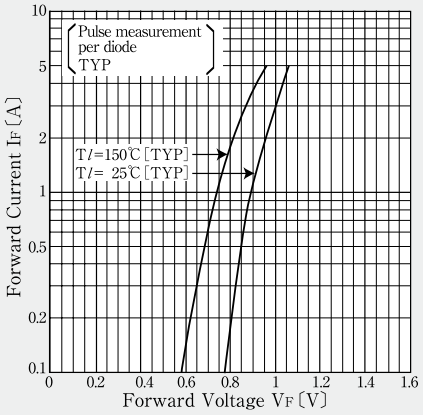
順電圧 Forward Voltage	VF	IF＝0.5A，パルス測定，1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR＝VRM，パルス測定，1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θjl	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 15	℃/W
	θja	接合部・周囲間 Junction to Ambient	*1 MAX 68	
			*2 MAX 84	

*1：プリント基板実装，銅箔パターン324mm²
On glass-epoxy substrate, copper soldering pad area 324mm²

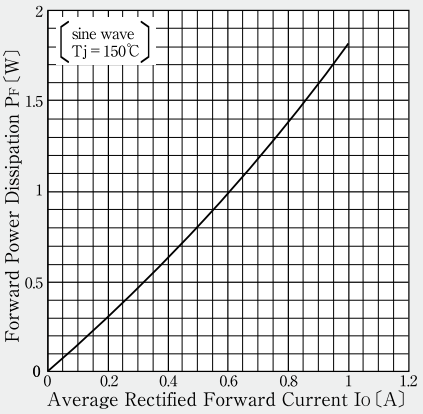
*2：プリント基板実装，銅箔パターン101mm²
On glass-epoxy substrate, copper soldering pad area 101mm²

■特性図　CHARACTERISTIC DIAGRAMS

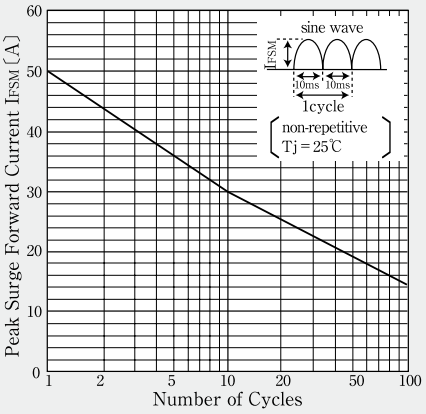
順方向特性
Forward Voltage



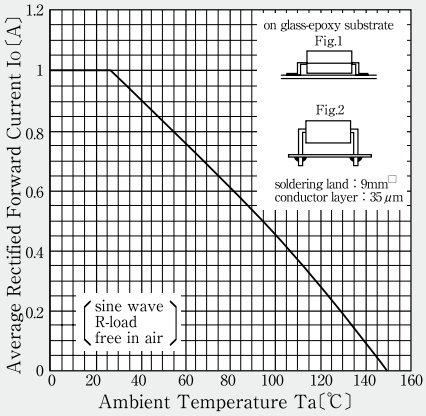
順電力損失曲線
Forward Power Dissipation



せん頭サージ順電流耐量
Peak Surge Forward Current Capability



ディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Io



＊ Sine wave は 50Hz で測定しています。
＊ 50Hz sine wave is used for measurements.
＊半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typical は統計的な実力を表しています。
＊ Semiconductor products generally have characterristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9